

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①① N° de publication :

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

3 001 097

②① N° d'enregistrement national :

14 50111

⑤① Int Cl⁸ : **H 03 K 17/12 (2013.01)**

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 08.01.14.

③③ Priorité : 15.01.13 US 13742086.

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 18.07.14 Bulletin 14/29.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : **TRIQUINT SEMICONDUCTOR, INC.**
— US.

⑦② Inventeur(s) : **PRABHAKAR RAVISHANKAR et
FURINO JR. JAMES P..**

⑦③ Titulaire(s) : **TRIQUINT SEMICONDUCTOR, INC..**

⑦④ Mandataire(s) : **CABINET PLASSERAUD.**

⑤④ **DISPOSITIF DE COMMUTATION AVEC DIVISEUR RESISTIF.**

⑤⑦ Des modes de réalisation proposent un dispositif de
commutation comprenant

un ou plusieurs transistors à effet de champ (FET) (104).
Dans des modes de réalisation, un diviseur résistif (132)
comprenant une première résistance (136) et une seconde
résistance (140) peut être couplé au FET à une position
électriquement entre une borne de grille (120) du FET et
une borne de corps (124) du FET.

FR 3 001 097 - A1

